

บทที่ 5

สรุปผล

5.1 สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองฝังไอโอนของอาร์กอนและออกซิเจนพลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลท์ ในหับทิมและแซฟไฟร์สังเคราะห์ ผลการทดลองสรุปได้ดังนี้

- i) การฝังไอโอนของอาร์กอนและออกซิเจน ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีหักเหในหับทิมและไฟลินสังเคราะห์
- ii) การฝังอาร์กอนไอโอนไม่ทำให้เกิดตัวหนีใหม่ขึ้นในหับทิมและไฟลินสังเคราะห์ ในขณะที่การฝังออกซิเจนไอโอน ทำให้เกิดตัวหนีชนิด F^+ ขึ้น เนื่องจากมีการคุณภาพลีนแสงที่ 240 นาโนเมตร และที่โดส 1×10^{18} ไอโอน/ ซม^2 หลังการอบที่อุณหภูมิ 800°C เวลา 1 ชั่วโมง มีการคุณภาพลีนแสงที่ 535 นาโนเมตร เนื่องจากอาจมีธาตุโครงเมียมในตัวอย่าง
- iii) ไม่พบ blister บริเวณผิวของตัวอย่างหลังการฝังไอโอน แต่เมื่ออบตัวอย่างที่ 800°C เวลา 1 ชม. พบ blister เกิดขึ้นในตัวอย่างที่ฝังด้วยออกซิเจนไอโอน โดย 1×10^{17} ไอโอน/ ซม^2 โดยปริมาณของ blister จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณโดสที่ใช้ และที่โดสสูง blister จะแตกออก
- iv) จากการวัดปริมาณโดสด้วย RBS บนตัวอย่างที่ฝังด้วยอาร์กอนไอโอน พบว่าได้สนับขึ้นตัวอย่างมีแนวโน้มคงที่ ซึ่งสอดคล้องกับโคด Profile code
- v) โครงสร้างบริเวณผิวที่ฝังไอโอนยังไม่ถูกลายเป็นร่องรอยฐานเนื่องจากรอยแตกของ blister ที่เกิดขึ้นมีการเรียงตัวไปในทิศทางเดียวกัน

จิรศิริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright[©] by Chiang Mai University

All rights reserved